

Школа молодых учёных и специалистов "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1 июля 2008 г.

Лекции

Бердников Владимир Степанович

Моделирование теплофизических процессов при получении чистого кремния, слитков и монокристаллов

Болховитянов Юрий Борисович

Эпитаксиальный рост пленок Si и SiGe

От имени авторов Ю.Б. Болховитянов, О.П. Пчеляков

Вяткин Анатолий Федорович

Макропористый кремний – технологии получения и актуальные применения

Герасименко Николай Николаевич

Радиационная стойкость наноструктур

От имени авторов Н.Н. Герасименко, Д.И. Смирнов

Зайцев Сергей Иванович

Современные и перспективные технологии наноструктурирования

Казанский Андрей Георгиевич

Аморфный и нанокристаллический кремний. Методы получения и основные физические свойства

Кобелева Светлана Петровна

Сопротивление растекания - динамично развивающийся метод прецизионного контроля распределения электрически активной примеси в субмикронных и нанометровых полупроводниковых структурах

Шульпина Ирэн Леонидовна

Высокоразрешающая рентгеновская топография при исследовании дефектов в кремнии

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Приглашённые доклады

Абросимов Николай Валентинович

Выращивание кристаллов твердого раствора кремний-германий

От имени авторов Н.В. Абросимов, В.Н. Курлов

Барабаненков Михаил Юрьевич

Резонансные оптические эффекты и новые оптические материалы кремниевой микрофотоники

Болховитянов Юрий Борисович

Эпитаксия GaAs на кремниевых подложках: Современное состояние исследований и разработок

От имени авторов Ю.Б. Болховитянов, О.П. Пчеляков

Бородин Алексей Владимирович

Оборудование для выращивания из расплава монокристаллов тугоплавких оксидов

От имени авторов А.В. Бородин, В.А. Бородин, Д.Н. Францев, Д.Б. Ширяев, М.В. Юдин

Герасименко Николай Николаевич

Радиационное формирование наноструктур в объемном монокристаллическом кремнии

Двуреченский Анатолий Васильевич

Физические явления и технологии в основе кремниевых наноструктур с квантовыми точками

Земсков Виктор Сергеевич

Развитие представлений о факторах, приводящих к возникновению полосчатой примесной микронеоднородности в монокристаллах кремния, выращиваемых методом Чохральского

Кведер Виталий Владимирович

Геттерирование примесей и инженерия дефектов в кремнии для солнечной энергетики

Конончук Олег Владимирович

Latest trends in SOI technology: Direct Silicon Bonding

Литовченко Владимир Григорьевич

Поведение кислорода в Cz- Si при термических обработках различного типа

От имени авторов И.П. Лисовский, В.Г. Литовченко, В.П. Кладько, В.Ф. Мачулин, М.В. Войтович, А.В. Сариков, С.А. Злобин

Мелентьев Павел Николаевич

Новый способ создания атомно-молекулярных наноструктур на поверхности методами атомной оптики

От имени авторов В.И. Балыкин, П.Н. Мелентьев

Новиков Алексей Витальевич

Люминесценция и фотопроводимость в области длин волн 1.3-1.55 мкм в SiGe гетероструктурах с самоформирующимися nanoостровками

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Приглашённые доклады (продолжение)

Пажин Дмитрий Михайлович

Сенсоры на основе структур «Кремний-на-Изоляторе»

От имени авторов В.Н. Мордкович, Д.М. Пажин

Резниченко Михаил Федорович

Кремний для солнечной энергетики

От имени авторов Ф.А. Кузнецов, М.Ф. Резниченко

Соболев Николай Алексеевич

Светодиоды на основе кремния

Тетельбаум Давид Исаакович

Нановключения элементов IV группы в оксидных диэлектриках

Ярыкин Николай Алексеевич

Свойства димеров кислорода в кремнии

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Устные доклады

Амиров Ильдар Искандерович

Формирование микроструктур с сверхвысоким аспектным отношением в кремнии в циклическом травлении/пассивации процессе в плазме SF₆/C₄F₈

От имени авторов И.И. Амиров, А.С. Шумилов

Андреев Борис Александрович

Излучательные свойства эпитаксиальных волноводных структур Si:Er/SOI

От имени авторов Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник, Д.И. Крыжков, А.Н. Яблонский, В.П. Кузнецов, T. Gregorkiewicz, N. Ha

Антонова Ирина Вениаминовна

Новые возможности при формировании нанокристаллов в диэлектрической матрице с использованием ионов высоких энергий

От имени авторов И.В. Антонова, В.А. Скуратов, I. Balberg

Арапкина Лариса Викторовна

Исследование методом СТМ поверхности кремния (001), получаемой в процессе низкотемпературного раскисления

От имени авторов Л.В. Арапкина, В.А. Юрьев, В.М. Шевлюга

Белько Виктор Иванович

Квантовохимическое моделирование формирования и диффузии собственных междоузельных атомов в напряженных кристаллах кремния

От имени авторов В. Е. Гусаков, В.И. Белко, Н.Н. Дорожкин

Бешенков Владимир Григорьевич

Диагностика фазового состава тонких оксидных пленок и их границ раздела с кремнием по оже-спектрам при ионном профилировании

От имени авторов В.Г. Бешенков, А.Ф. Вяткин, А.Г. Знаменский, В.А. Марченко

Брантов Сергей Константинович

Выращивание слоев кремния из расплава на углеродных подложках

Вдовин Владимир Ильич

Механизмы генерации дислокаций в Si структурах с напряженными слоями: собственные точечные дефекты в процессах зарождения дислокаций

Воронкова Галина Ивановна

Генерация термодоноров в кремнии с различными ростовыми микродефектами

От имени авторов В.В. Воронков, Г.И. Воронкова, А.В. Батунина, Н.Б. Тюрина, А.С. Гуляева, В.Н. Головина, М.Г. Мильвидский

Гоник Михаил Александрович

Использование погруженного ОТФ нагревателя для выращивания мультикристаллического кремния

От имени авторов М.А. Гоник, А.И. Непомнящих

Денисенко Юрий Иванович

Формирование наноразмерной пористой структуры в кремнии, имплантированном фосфором и кислородом

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Устные доклады (продолжение)

Дерябин Александр Сергеевич

Использование твердых растворов GeSi, полученных с помощью низкотемпературной эпитаксии, для создания структур с повышенной подвижностью носителей зарядов

От имени авторов А.С. Дерябин, Л.В. Соколов, С.В. Зайцев-Зотов, В.Ф. Насретдинова

Итальянцев Александр Георгиевич

Эффекты в кремнии, обусловленные химическими реакциями на его поверхности

Кведер Виталий Владимирович

Инвертированный сигнал нестационарной емкостной спектроскопии (DLTS) от дислокаций в кремнии

От имени авторов В.В. Кведер, В.И. Орлов, М. Хорошева

Кибалов Дмитрий Станиславович

Волнообразные наноструктуры на поверхности кремния, инициируемые ионной бомбардировкой

От имени авторов В.К. Смирнов, Д.С. Кибалов

Крыжков Денис Игоревич

«Запасенная» электролюминесценция в диодных структурах Si:Er/Si

От имени авторов Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник, Д.И. Крыжков, А.Н. Яблонский, В.П. Кузнецов, T. Gregorkiewicz, W. Jantsch

Маковийчук Мирослав Иванович

Разработка кремниевого фликкер-шумового газового сенсора для селективного детектирования хлорорганических соединений в окружающей газовой среде

Плюснин Николай Инокентьевич

Формирование, электронная структура и стабильность пленочных наночастиц переходных металлов на кремнии

От имени авторов Н.И. Плюснин, В.М. Ильященко, С.А. Китань, С.В. Крылов

Ратников Валентин Вячеславович

Рентгендифрактометрический анализ эволюции структуры и деформаций в слоях пористого кремния

От имени авторов В.В. Ратников, В.И. Соколов, Л.М. Сорокин, А.Е. Калмыков

Рожков Александр Владимирович

Влияние дефектов структуры на характеристики SiGe/Si композиций, изготовленных прямым сращиванием

От имени авторов И.В. Грехов, Л.М. Сорокин, Т.С. Аргунова, Л.С. Костина, А.В. Рожков, Е.И. Белякова, Ш.А. Юсупова, И.Г. Атабаев, Н.А. Матчанов, О.Р. Ражабова

Суворов Эрнест Витальевич

Особенности дифракции рентгеновских лучей на деформационных полях единичных дислокаций в кремнии в методах высокоразрешающей секционной топографии

От имени авторов Э.В. Суворов, И.А. Смирнова

Терещенко Алексей Николаевич

Особенности взаимодействия меди с дислокациями в кремнии

От имени авторов А.Н. Терещенко, Э.А. Штейнман

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"

Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Устные доклады (продолжение)

Токарев Владимир Евгеньевич

Промышленное производство слитков мультикристаллического кремния в России

От имени авторов В.Е. Токарев, Н.А. Потолоков, Н.М. Решетников, А.В. Серов, И.С. Кутовой

Феклисова Ольга Владимировна

Исследования емкостными методами массивов нанокластеров Ge, выращенных в кремниевой матрице методом молекулярно-лучевой эпитаксии

От имени авторов О.В. Феклисова, Е.Б. Якимов, Л.В. Арапкина, В.П. Калинушкин, В.А. Чапнин, К.В. Чиж, В.А. Юрьев

Хируненко Людмила Ивановна

Диффузия кислорода в соединениях Si_{1-x}Ge_x

От имени авторов А.В. Дуванский, Ю.В. Помозов, М.Г. Соснин, Л.И. Хируненко, Н.В. Абросимов, Х. Римап

Юхневич Анатолий Викторович

Кремниевый лазер на основе излучающих структурных дефектов

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Стендовые доклады

И.П. Лисовский, В.Г. Литовченко, М.В. Войтович, С.А. Злобин

Подавление рекомбинационных потерь в Si - наноразмерных структурах

Е.С. Демидов, А.И. Белов, А.Н. Михайлов, С.А. Филиппов, А.Б. Костюк, А.В. Ершов,
Д.И. Тетельбаум

**Электронный транспорт через тонкие оксидные пленки на кремнии,
наноструктурированные путем имплантации ионов Si**

В.А. Терехов, Э.П. Домашевская

Синхротронные исследования наноструктур на основе кремния

В.Е. Гусаков

**Диффузионные процессы и дефектообразование в наноструктурных материалах:
квантовохимическое моделирование**

В.Е. Гусаков, Н.А. Поклонский, Ю.В. Гусакова

Моделирование роста и структурной устойчивости кремниевых нанотрубок

А.А. Жохов, Г.А. Емельченко

**Выращивание монокристаллов карбида кремния с использованием движущегося
тигля**

Н.А. Вerezуб, В.Ю. Жвирблянский, М.Г. Мильвидский, А.И. Простомолотов

**Моделирование и оптимизация конструкции теплового экрана в установке
«Редмет-90» для выращивания монокристаллов кремния большого диаметра**

А.И. Простомолотов, Н.А. Вerezуб, М.В. Меженный, М.Я. Мильвидский, В.Я. Резник

**Моделирование тепловых процессов и дефектообразования при выращивании и
термообработке бездислокационных монокристаллов и пластин кремния**

А.А. Стук, Н.Г. Колин, И.В. Даниленко, С.Л. Олимпиев, Т.П. Свистельникова

**Ядерно-легированный кремний — базовый материал для производства
современных приборов отечественной силовой электроники**

К.Б. Фрицлер, В.В. Калинин, Е.М. Труханов, А.В. Колесников

**Исследование однородности распределения электрофизических параметров
монокристаллов БЗП кремния**

Д.С. Бровин, А.А. Ловцюс, М.Э. Рудинский

**Аспекты выбора высоты реактора для восстановления кремния по SIEMENS
технологии**

В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, Г.И. Пальченок, О.С. Рабинович, А.В. Акулич,
В.В. Корбан

Технология кипящего слоя в производстве поликристаллического кремния

М.Я. Дашевский, О.В. Минькова, С.Л. Сорокин, О.М. Кугаенко, М.И. Петржик,
М.В. Меженный, В.Ф. Павлов, В.В. Хасиков, В.С. Ежлов, Л.А. Голубева, Ю.С. Панарина

**Влияние параметров процесса выращивания бездислокационных монокристаллов
кремния на их механические свойства**

А.В. Богомаз, Т.В. Критская, А.Н. Рябец

Особенности свойств кристаллического кремния, содержащего водород

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Стендовые доклады (продолжение)

Т.В. Критская, В.А. Скачков

Влияние технологических факторов процессов выращивания на получение однородных монокристаллов кремния

В.Д. Гольшев

Новые ОТФ методы выращивания кристаллов: Первоначальный опыт использования и перспективы

О.В. Александров, А.И. Дусь

Объемная модель быстрого термического окисления кремния

И.В. Грехов, Л.М. Сорокин, Л.С. Костина, Т.С. Аргунова, Е.И. Белякова, Ш.А. Юсупова, А.В. Рожков, С.И. Трошков, Н.И. Шмидт, И.Г. Атабаев, Н.А. Матчанов

Структурные и электрические исследования SiGe-on-insulator (SGOI) подложек, изготовленных прямым сращиванием

Н.Д. Абросимова, М.Н. Минеев, В.Д. Скупов, О.П. Смелова, А.И. Чепель

Низкотемпературная релаксация микрорельефа поверхности и электрического сопротивления приборных слоев структур КНИ после рентгеновского облучения

А.В. Колесников, Е.М. Труханов, А.С. Дерябин, А.С. Ильин, А.П. Василенко, А.Ю. Красотин

Особенности пластической релаксации пленок GeSi, выращенных на различных вицинальных (001) Si подложках

С.А. Денисов, В.Г. Шенгуров, С.П. Светлов, В.Ю. Чалков, Е.А. Питиримова

Исследование структуры эпитаксиальных слоев кремния, выращенных на подложках сапфира, поверхность которых очищена молекулярным потоком

В.В. Овчаров, В.И. Рудаков

Математическая модель диффузии атомов примеси в ультратонких слоях кремния с неоднородным распределением температуры

С.А. Денисов, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, Д.В. Шенгуров, Е.А. Питиримова, Ю.Н. Дроздов

Эпитаксиальное наращивание методом молекулярно-лучевой эпитаксии слоев SiGe на структурах кремний-на-сапфире и кремний-на-изоляторе

П.Г. Сенников, С.В. Голубев, В.И. Шашкин, Д.А. Пряхин, Б.А. Андреев, С.А. Гусев, А.С. Кузнецов

Плазмохимическое осаждение нанокристаллического кремния из высокочистого тетрафторида кремния

А.И. Никифоров, В.В. Ульянов, В.А. Тимофеев, О.П. Пчеляков, С.А. Тийс, А.К. Гутаковский

Начальные стадии роста напряженных SiGe структур с квантовыми точками методом МЛЭ

В.В. Углов, Н.Т. Квасов, Ю.А. Петухов, В.М. Асташинский, А.М. Кузьмицкий
Силицидообразование в системе титан-кремний в результате воздействия компрессионными плазменными потоками

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Стендовые доклады (продолжение)

О.И. Семенова, Р.Г. Шарафутдинов, В.Г. Щукин

Эпитаксия кремния с использованием метода электронно-пучковой плазмы

Р.В. Гольдштейн, В.А. Городцов, П.С. Шушпанников, С.W. Liu, С.-Н. Lee

Напряжённо-деформированное состояние в кремний-германиевых трёхслойных гетероструктурах

В.В. Балашев, В.В. Коробцов, Т.А. Писаренко, Е.А. Чусовитин

Твердофазная эпитаксия островков силицида железа на чистой поверхности Si(001)2x1

И.И. Пронин, М.В. Гомоюнова, Д.Е. Малыгин

Взаимодействие атомов железа с поверхностью Si(111)7x7: Фазовый состав и магнитное упорядочение интерфейса Fe/Si

С.М. Тарасова, Л.А. Павлова, А.И. Непомнящих

Изучение структуры мультикристаллов солнечного кремния методом РСМА

А.Г. Казанский

Проблемы определения оптической ширины зоны в микроструктурированном кремнии

Р.В. Пресняков, П.П. Сарычев, Ю.В. Сокольникова, А.И. Непомнящих

Распределение примесей при выращивании мульти- и монокремния из рафинированного технического кремния

П.М. Гаврилов, Ю.А. Ревенко, В.А. Гаврилов, А.С. Перетокин

О проблеме обращения SiCl₄ в производстве поликристаллического кремния

В.В. Старков

Наноструктурирование на основе пористого кремния

Л.В. Арапкина, Б.П. Горшунов, Е.С. Жукова, В.П. Калинушкин, Г.Н. Михайлова, А.С. Прохоров, В.А. Чапнин, К.В. Чиж, В.А. Юрьев

Терагерцовая проводимость гетероструктур Ge/Si(001) с квантовыми точками

Л.В. Арапкина, В.А. Юрьев

Начальная стадия роста квантовых точек Ge на поверхности Si(001) при низких температурах

В.И. Рудаков, Ю.А. Денисенко, Б.В. Мочалов, В.В. Овчаров, С.Г. Симакин

Особенности эволюции концентрационных профилей атомов легирующих примесей при БТО кремниевых пластин в неизотермическом реакторе

В.И. Рудаков, В.В. Овчаров, В.П. Пригара

Проблема температурной неустойчивости при быстром термическом отжиге кремниевых пластин с помощью некогерентного излучения

А.А. Жохов, В.М. Масалов, Д.В. Матвеев, М.Ю. Максимук, И.И. Зверькова, С.З. Шмурак, А.П. Киселев, А.В. Баженов, Г.А. Емельченко

Синтез нанокристаллов α -SiC при карботермическом восстановлении сферических наночастиц аморфного диоксида кремния

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Стендовые доклады (продолжение)

А.Е. Усенко, А.В. Юхневич

Анизотропное растворение монокристаллического кремния вблизи края химической маски на поверхности (001)

В.М. Кашкаров, И.В. Назариков, А.С. Леньшин, В.А. Терехов, Б.Л. Агапов, Э.П. Домашевская, К.Н. Панков

Морфология и электронное строение пористого кремния, полученного анодным травлением без HF

В.А. Терехов, К.Н. Панков, С.Ю. Турищев, В.М. Кашкаров, Э.П. Домашевская, Д.И. Тетельбаум, А.Н. Михайлов, А.И. Белов

Исследование формирования нанокластеров элементарного кремния в матрице оксида кремния при отжиге плёнок SiO_x

С.Ю. Турищев, А.С. Леньшин, В.М. Кашкаров, В.А. Терехов, Э.П. Домашевская
Эволюция фазового состава и электронно-энергетического строения пористого кремния в процессе естественного старения

Р.И. Баталов, Р.М. Баязитов, Д.И. Крыжков, П.И. Гайдук, Г.Д. Ивлев

Особенности импульсной обработки слоев кремния, имплантированных ионами эрбия

М.И. Маковийчук

Низкочастотно-шумовая спектроскопия - диагностический инструмент дефектно-примесной инженерии в микротехнологии

И.В. Антонова, Е.П. Неустроев, С.А. Смагулова, J. Jedrzejewski, I. Balberg

Зарядовая спектроскопия нанокристаллов кремния в матрице SiO₂

Е.В. Коротков, Д.А. Павлов, П.А. Шиляев, Н.О. Кривулин, М.В. Треушников

Исследование ультратонких слоёв кремния на сапфире методами микроскопии латеральных сил и режима Z-модуляции

А.С. Леньшин, В.М. Кашкаров, С.Ю. Турищев, Б.Л. Агапов, Э.П. Домашевская

Синхротронные исследования электронного строения нанокомпозитов железа и кобальта на основе пористого кремния

С.Ю. Турищев, В.А. Терехов, В.М. Кашкаров, К.Н. Панков, Д.А. Ховив, Э.П. Домашевская

Особенности ближней тонкой структуры края рентгеновского поглощения многослойных наноструктур Al₂O₃/SiO₂/Al₂O₃/SiO₂...Si(100)

Б.А. Андреев, Н.В. Абросимов, П.Г. Сенников

Изотопические эффекты в спектрах фотовозбуждения и проблемы определения примесей в моноизотопном кремнии

Л.М. Сорокин, Т.С. Аргунова, Л.С. Костина, М.П. Щеглов, J.H. Je, J.W. Jung, Н.В. Абросимов

Использование белого синхротронного излучения для исследования дефектов структуры в SiGe монокристаллах и композициях SiGe/Si

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Стендовые доклады (продолжение)

М.С. Журавель, А.Е. Корзун, А.Н. Петлицкий, В.И. Плебанович
Система контроля пластин кремния для субмикронной технологии

И.М. Анфимов, С.П. Кобелева, В.А. Козлов, А.Н. Чиякин
Установка для измерения сопротивления растекания полупроводниковых структур ВИК-УЭС СР

И.Л. Шульпина, С.С. Рувимов, Р.Н. Кютт
Рентгенодифракционное исследование сильнолегированных монокристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского

В.М. Владимиров, Э.Ф. Гринин, М.Е. Сергей, В.Н. Шепов
Автоматизированная установка «Ромер» для измерения удельного электросопротивления пластин и слитков монокристаллического кремния

Н.Д. Абросимова, В.Д. Скупов
Эффект дальнего действия в кремнии при ионно-плазменном травлении

М.В. Меженный, М.Г. Мильвидский, В.Я. Резник
Влияние быстрого термического отжига на формирование эффективной геттерирующей среды в пластинах кремния

М.В. Меженный, М.Г. Мильвидский, В.Я. Резник
Генерация дислокаций в термообработанных пластинах кремния, легированных азотом, при приложении внешних нагрузок

Г.И. Воронкова, В.В. Воронков, А.В. Батунина, В.Н. Головина, Н.Б. Тюрина, А.С. Гуляева, М.Г. Мильвидский
Захват электронов димерными центрами азота в кремнии

К.В. Феклистов, Л.И. Федина, А.Г. Черков
Расслоение ансамбля преципитатов бора в кремнии, созданного высокодозной имплантацией и отжигом, в результате Оствальдовского созревания в неоднородных условиях

Р.В. Гольдштейн, К.Б. Устинов, П.С. Шушпанников, М.Г. Мильвидский, М.В. Меженный, В.Я. Резник
Моделирование процессов дефектообразования в анизотропных пластинах кремния со встроенным внутренним геттером

Л.Ф. Макаренко, Ф.П. Коршунов, С.Б. Ластовский, Н.М. Казючиц
Влияние примеси кислорода на электрические свойства кластеров дивакансий в кремнии, облученном нейтронами

А.И. Белоус, Ю.Б. Васильев, В.А. Емельянов, В.Б. Оджаев, В.И. Плебанович, П.К. Садовский, А.Р. Челябинский
Структурные и электрофизические параметры сильно легированных слоев Si n-типа, созданных ионной имплантацией

В.В. Кведер, В.И. Орлов, М. Хорошева
Влияние движения дислокаций в кремнии на их спектры глубоких уровней

Конференция "КРЕМНИЙ-2008"
Черноголовка, 1-4 июля 2008 г.

Стендовые доклады (продолжение)

В.И. Орлов

Влияние азота на подвижность дислокаций и стартовые напряжения в Cz-Si

В. Еременко, J.-L. Demenet, D. Eyidi, J. Rabier

Дислокации в Si – проблемы и новые результаты

И.М. Анфимов, С.П. Кобелева, Д.А. Кузьмин, В.В. Лемешко, А.М. Мусалитин,
Ю.В. Осипов, И.В. Борзых, О.В. Торопова

Энергия активации отжига радиационных дефектов в БЗП МК, облученного высокоэнергетичными электронами

О.В. Феклисова, Е.Б. Якимов

Влияние протяженных дефектов на диффузию золота в пластически деформированном кремнии

В.В. Карзанов, К.В. Сидоренко, М.О. Марычев, Н.А. Добычин

Фотолюминесценция нитрида кремния

А.Д. Мокрушин, Н.М. Омеляновская, Д.М. Пажин, В.П. Гончаров

Радиационные эффекты в двухзатворных полевых датчиках холла на основе КНИ-структуры

С.А. Леготин, В.Н. Мурашев

Прецизионный кремниевый датчик температуры

В.Б. Шмагин, Д.Ю. Ремизов, В.П. Кузнецов, С.В. Оболенский, В.А. Козлов, З.Ф. Красильник

Туннельно-пролетные светодиоды на основе Si:Er, излучающие в диапазоне 1.5 мкм при комнатной температуре

Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук, В.С. Шпаковский, В.А. Филипена, С.Б. Ластовский, В.А. Скуратов

Влияние облучения высокоэнергетическими ионами ксенона на дифференциальную проводимость обратносмещенных кремниевых p+n диодов

Н.М. Казючиц, А.С. Шуленков, Т.Л. Ковалева, Л.Ф. Макаренко, Б.Д. Алехно

Реализация светоизлучающих диодов, световодов и фотодиодов на основе

К.Е. Кудрявцев, В.Б. Шмагин, Д.В. Шенгуров, З.Ф. Красильник

Предельно узкие линии электролюминесценции в Si:Er/Si диодных структурах

А.Е. Калядин, Н.А. Соболев, Е.И. Шек, А.Н. Якименко

Влияние алюминиевого геттерирования на интенсивность дислокационной люминесценции в кремнии

М.В. Степихова, Л.В. Красильникова, Н.А. Байдакова, З.Ф. Красильник, В.Ю. Чалков, В.Г. Шенгуров

Оптически активные центры иона Er³⁺ в гетроструктурах Si/Si_{1-x}Gex